

Transistor Mosfet IRF740 400V 10A Tipo N

Codigo: **113175**



Descripción

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica, ya sea en circuitos analógicos o digitales.

El IRF740PBF es un MOSFET de potencia de canal N de 400 V, el MOSFET de potencia de tercera generación proporciona al diseñador la mejor combinación de conmutación rápida, diseño de dispositivo robusto y baja resistencia.

- Baja resistencia térmica
- Tecnología de proceso avanzada
- Clasificación dinámica dv / dt
- Cambio rápido
- Totalmente avalancha nominal
- Facilidad de paralelismo
- Requisito de manejo simple
- Aplicaciones: Administración de potencia, industrial, dispositivos portátiles, electrónica de consumo

Información Básica

- Polaridad del transistor: Canal N
- Tensión drenaje-fuente V_{ds} : 400 V
- Tensión V_{gs} de medición $R_{ds(on)}$: 10 V
- Tensión umbral V_{gs} : 4 V
- Intensidad drenador continua I_d : 10 A
- Resistencia de activación $R_{ds(on)}$: 550 mohm
- Disipación de potencia P_d : 125 W
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 150 °C
- Encapsulado TO-220
- 3 pines

Sustituto

- NTE2397